

製品情報(法人向け/産業用)



PCIe M.2 SSDs

MTE662T & MTE662T-I

トランセンドのMTE662TはPCI Express (PCIe) Gen 3 x4インターフェースを採用し、NVM Express (NVMe) 1.3に準拠したM.2 SSDです。96層の3D NANDフラッシュを採用したことで、64層のものよりもストレージ効率が優れています。DRAMキャッシュによる高速アクセスと3K P/Eサイクルの耐久性を提供します。

幅広い温度帯(-40°C ~ 85°C)で動作可能なMTE662T-Iはミッションクリティカルなアプリケーション等で利用できます。

ハードウェアの機能

- DDR4 DRAMキャッシュ搭載
- 耐久性: 3K P/Eサイクル
- PCIe Gen 3 x4インターフェース
- 高速パフォーマンスを提供する8CHコントローラ
- 主要部品にはコーナードット技術を適用しています

ファームウェアの機能

- NVMeコマンド対応
- SLCキャッシュ
- LDPC ECC機能
- ダイナミック・サーマル・スロットリング
- ウェアレベリングとブロックマネージメント

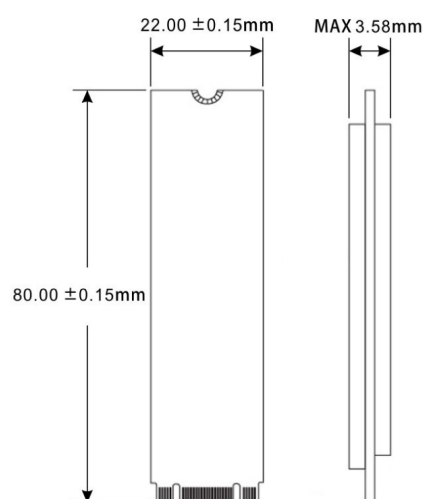
製品情報

512GB	TS512GMTE662T TS512GMTE662T-I
1TB	TS1TMTE662T TS1TMTE662T-I
2TB	TS2TMTE662T TS2TMTE662T-I

仕様

外観	サイズ	80 mm x 22 mm x 3.58 mm (3.15" x 0.87" x 0.14")
	重量	9 g (0.32 oz)
	フォームファクタ	M.2
	M.2規格	2280-D2-M (両面実装)
インターフェース	バスインターフェース	NVMe PCIe Gen3 x4
ストレージ	フラッシュ種類	3D NANDフラッシュ
	容量	512 GB / 1 TB / 2 TB
動作環境	動作電圧	3.3V±5%
	動作環境温度	標準 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)
		広域温度 -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F)
	保管温度	-40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F)
	湿度	5% ~ 95%
	耐衝撃	1500 G、0.5 ms、3軸
	耐振動(動作時)	20 G (最大振幅), 7 Hz ~ 2000 Hz (周波数)
電源	消費電力(動作時)	7.0 ワット
	消費電力 (IDLE)	1.0 ワット
データ転送スピード	シーケンシャルリード/ライト(CrystalDiskMark, 最大値)	読出し: 最大 3,500 MB/s 書込み: 最大 2,700 MB/s
	4Kランダムリード/ライト(IOMeter, 最大値)	読出し: 最大 340,000 IOPS 書込み: 最大 355,000 IOPS
	MTBF [平均故障間隔]	3,000,000 時間
	TBW [総書込み容量] (最大値)	4,400 TBW
	DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]	2 (3 年)
保証	認証	CE / FCC / BSMI
	保証	3年保証

寸法



製品仕様は予告なしに変更することがあります。そのため、掲載写真が実際の製品と異なる場合がございます。また、使用可能な製品容量は使用環境によって異なります。メモリ製品を使用するインダストリアルアプリケーションは多岐に渡り、使用条件や環境も様々であるため、トランセンドは全ての機器との互換性やあらゆる条件での安定動作を保証することができません。特定のアプリケーションや環境での使用を検討する際は事前にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。